

Второе извещение



**Физический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова,
Физико-Технический Институт
имени А.Ф.Иоффе РАН,
Российская Академия Наук**



**7-я Всероссийская Конференция
«Нитриды галлия, индия и алюминия:
структуры и приборы»
Физический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова
Москва, 1 - 3 февраля 2010 г.**

<http://nitrides-conf.ioffe.ru>

1-3 февраля 2010 года в Москве, на физическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова, состоится **7-я Всероссийская Конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы»**.

Предыдущие конференции этой серии проходили в 2001-08 гг. попеременно в Москве и Санкт-Петербурге. Им предшествовали четыре рабочих совещания (1997-2000).

Совещания и Конференции демонстрировали постоянно возрастающую активность в области Ш-Н в России, и в Конференции 2008г. приняли участие более 200 человек, представивших более 80 докладов от более 60 организаций: ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, ИФП СО РАН, ГИРЕДМЕТ, МИСИС, ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», ООО «Прософт Технолоджи» и др.

Спонсорами Конференции 2008 г. были РФФИ, ГК «РоснаноТех», фирмы Aixtron, VEECO, «Светлана-Оптоэлектроника», «Нитридные кристаллы», TDI, «Прософт Технолоджи». «Научное и технологическое оборудование» (SemiTec).

Конференция будет проходить в форме устных и стендовых сессий. Официальный язык Конференции – русский. Доклады от зарубежных участников могут быть сделаны на английском языке. На Конференции будет организована выставка промышленных компаний.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Технология материалов: рост объемных кристаллов и подложки для эпитаксиального роста.
2. Технология материалов: эпитаксиальные методы роста.
3. Оптические, электрические, магнитные и другие свойства материалов.
4. Квантово-размерные структуры на основе нитридов.
5. Постростовые технологии обработки нитридных материалов.
6. Электронные, фотоэлектрические и другие приборы на основе нитридов.
7. Светодиоды и лазеры на основе нитридов.
8. Специальная сессия "Энергосберегающее освещение на основе полупроводниковых технологий".

UV-2010

Совместно с конференцией будет проводиться **2-й Международный Семинар по использованию ультрафиолетовых светодиодов в приборах и системах**. Семинар состоится 3-го февраля по окончании работы конференции.

Список приглашенных докладов

L. Chernyak, University of Central Florida

«Studies of the Effects of Electron Injection in III-Nitrides and Other Wide Band Gap Semiconductors»

А.Ф. Пацульников, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

«Мост через «зеленую долину». По пути к RGB источникам белого света»

M. Fouksman, Philips Lumileds

«Mechanisms of efficiency droop in blue III-N LEDs»

Р.А.Талалаев, STR Group

«Моделирование в технологии полупроводников: от объемного роста до приборных характеристик»

Н.П.Сошин, ФГУП «Платан»

«Современные эффективные люминофоры для приборов твердотельного освещения»

А.Я. Поляков, «Гиредмет»

«Эффективность вхождения компонентов твердых растворов, примесей и образование дефектов при выращивании слоев и структур нитридов III группы в направлениях, отличных от [0001]»

Ф.И.Маняхин, МИСИС

«Проблемы деградации, надежности и стабильности параметров светодиодов как источников освещения»

В.В.Лундин, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

«Контроль поверхностных процессов в оптимизации роста III-N материалов»

В.Е. Кудряшов, ГК Роснанотех.

«Инициатива РОСНАНО в области твердотельного освещения»

Жмерик В.Н., ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

«AlGaN гетероструктуры для оптоэлектроники глубокого УФ диапазона, полученные методом МПЭ с плазменной активацией»

Е.В.Долин, НТИЦ Уникального Приборостроения

РАН. *«Проблемы создания стандартов и норм для светодиодного освещения»*

В.Ю.Давыдов, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

«Раман-спектроскопия сверхрешеток AlN-GaN и AlGaIn-GaN»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАТЫ

Предварительная регистрация:

Форма и правила заполнения приведены на сайте конференции, срок регистрации – до **1 НОЯБРЯ 2009 г.**

Тезисы докладов:

Объем тезисов доклада - 2 страницы (для приглашенных докладов - 4 страницы). Правила форматирования и образцы размещены на сайте конференции. Срок представления тезисов – до **1 ДЕКАБРЯ 2009 г.**

Финансовая поддержка участников:

Оргкомитет обратился в РФФИ и к возможным спонсорам («Роснано», «Ростехнологии», «Росэлектроника», AIXTRON, VEECO, ФГУП УОМЗ, LayTec, «Светлана - Оптоэлектроника», «Нитридные кристаллы», «Научное и технологическое оборудование»).

Российские участники получают финансовую поддержку в зависимости от выделенных средств и сроков предварительной регистрации.

На сайте конференции в разделе «Лента новостей» размещаются текущие новости и объявления для участников. Просьба регулярно читать этот раздел сайта.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель

Н.Н.Сысоев МГУ им. М.В.Ломоносова

Зам. председателя

А.Э.Юнович МГУ им. М.В.Ломоносова

Зам. председателя

П.С.Копьев ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

Ученый секретарь

А.Н.Туркин МГУ им. М.В.Ломоносова

Ученый секретарь

В.В.Лундин ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

А.А.Арендаренко, ЗАО "Элма-Малахит"

В.Н.Данилин, ГУП "Пульсар"

П.В.Иванников, МГУ им. М.В.Ломоносова

В.Е.Кудряшов, ГК "Роснанотех"

В.П.Чалый, "Светлана-Рост"

Г.В.Иткинсон, ЗАО "Светлана -Оптоэлектроника"

В.Г.Терехов, ФГУП "ПО "УОМЗ""

Н.Н.Бакин, ОАО "НИИПП"

А.Е.Николаев, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

М.А.Ормонт, МГУ им. М.В.Ломоносова

М.Н.Маргышов, МГУ им. М.В.Ломоносова

М.В.Чукичев, МГУ им. М.В.Ломоносова

П.Ю.Боков, МГУ им. М.В.Ломоносова

М.В.Рыжков, ООО "Прософт Технолджи"

Е.Е.Заварин, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель

А.Э.Юнович, МГУ им. М.В.Ломоносова

Зам. председателя

П.С.Копьев, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

Ученый секретарь

А.В.Сахаров, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

С.В.Иванов, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

Л.М.Коган, НИЦ "Оптэл"

В.В.Лундин, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

Ю.Н.Макаров, ООО "Нитридные кристаллы"

А.Н.Ковалев, МИСИС

А.А.Вилисов, ОАО "НИИПП"

О.П.Пчеляков, ИФП СО РАН

В.Г.Сидоров, СПбГТУ

С.Ю.Шаповал, ИПТМ РАН

С.Ю.Карпов, "Софт-Импакт"

Е.В.Луценко, ИФ НАН Беларуси

В.М.Устинов, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН